

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年3月10日(10.03.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/049935 A1

(51) 国際特許分類:
C04B 35/596 (2006.01) *C23C 14/34* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/027940

(22) 国際出願日: 2021年7月28日(28.07.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2020-148519 2020年9月3日(03.09.2020) JP

(71) 出願人: J X 金属株式会社 (JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION) [JP/JP];
〒1058417 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 岩淵 靖幸 (IWABUCHI, Yasuyuki);
〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X金属株式会社磯原工場内 Ibaraki (JP).

(74) 代理人: アクシス国際特許業務法人 (AXIS PATENT INTERNATIONAL); 〒1050004 東京都港区新橋二丁目6番2号 新橋アイマークビル Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,

TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) **Title:** SPUTTERING TARGET, MANUFACTURING METHOD THEREFOR, AND MANUFACTURING METHOD FOR MAGNETIC RECORDING MEDIUM

(54) 発明の名称: スパッタリングターゲット、その製造方法、及び磁気記録媒体の製造方法

(57) **Abstract:** A purpose of the present invention is to lower the specific resistance of a sputtering target containing silicon nitride (Si_3N_4). Provided is a sputtering target containing Si_3N_4 , SiC , MgO , and TiCN , and having a specific resistance of $10 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}$ or less.

(57) 要約: 窒化珪素 (Si_3N_4) を含有するスパッタリングターゲットの比抵抗を低くする。 Si_3N_4 、 SiC 、 MgO 、及び TiCN を含有し、比抵抗が $10 \text{ m}\Omega \cdot \text{cm}$ 以下であるスパッタリングターゲット。



WO 2022/049935 A1